

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Ngọc Hiếu

2. Ngày tháng năm sinh: 11/12/1979; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☐

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 64 An Nhơn
7, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ
cao, Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0948959559;

E-mail: hieunn@duytan.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ 11/2001 đến 10/2011: Giáo viên tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị

Từ 07/2010 đến 06/2011: Nghiên cứu viên Sau tiến sĩ tại North Carolina Central University (Hoa Kỳ)

Từ 11/2011 đến 01/2013: Giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn

Từ 02/2013 đến 09/2014: Cán bộ nghiên cứu kiêm Giảng viên tại Trường Đại học Duy Tân

Từ 09/2014 đến 10/2018: Phó Viện trưởng thường trực Viện nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao tại
Trường Đại học Duy Tân

Từ 10/2018 đến 06/2025: Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao tại Đại học Duy Tân

Chức vụ hiện nay: Viện trưởng; Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng

Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Duy Tân

Địa chỉ cơ quan: 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236-3650403

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường Đại học Đồng Tháp

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

Trường Đại học Đồng Tháp

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 29 tháng 06 năm 2001, số văn bằng: B0327045, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 27 tháng 02 năm 2009, số văn bằng: KH004376, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý bán dẫn

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, Belarus

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 05 tháng 12 năm 2016, ngành: Vật lý

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Duy Tân

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu tính chất điện tử của vật liệu nano carbon một chiều.
- Nghiên cứu tính chất vật lý của vật liệu hai chiều có cấu trúc lớp và dị cấu trúc van der Waals.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) ... HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 70 bài báo khoa học, trong đó 63 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Bằng khen	Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng	2020
2	Bằng khen	Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng	2021
3	Bằng khen	Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng	2022
4	Bằng khen	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo	2025

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Là một giảng viên, tôi luôn ý thức rõ về vai trò, trách nhiệm và những tiêu chuẩn nghề nghiệp cần đạt được trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cũng như trong các hoạt động phục vụ cộng đồng và phát triển chuyên môn.

Luôn chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và các quy định của Nhà trường. Có phẩm chất đạo đức tốt. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của một người giảng viên theo Luật giáo dục và Điều lệ trường Đại học. Có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ tốt, có đủ sức khỏe để công tác. Nhiệt tình trong công tác và có trách nhiệm với sinh viên, đam mê nghiên cứu khoa học. Tôi tích cực tham gia các hoạt động

nghiên cứu khoa học đồng thời định hướng người học nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, tôi không ngừng học hỏi, tham gia các lớp bồi dưỡng, hội thảo chuyên môn để nâng cao trình độ và năng lực nghề nghiệp. Luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học; đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Tích cực và có trách nhiệm trong các nhiệm vụ phục vụ cộng đồng.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 12 năm 07 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1								
2								
3								
03 năm học cuối								
4	2022-2023					114.6		114.6/114.6/67.5
5	2023-2024					115.2	157.5	272.7/272.7/67.5
6	2024-2025					86.4	270	356.4/356.4/67.5

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Nga

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☒:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Cộng hòa Belarus năm 2009

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2 /BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVC H/CK 2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Đỗ Mười	X		X		07/2017 đến 12/2022	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh	26/04/2023
2	Võ Thị Tuyết Vi	X		X		12/2018 đến 04/2022	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế	27/07/2022

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi được công nhận PGS/TS							
1	Tính chất vật lý của vật liệu hai chiều có cấu trúc bất đối xứng Janus	CK	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2025	1	MM	(1-252)	Giấy xác nhận sử dụng sách Số 779/GXN-ĐHDT ngày 20/06/2025 của Giám đốc Đại học Duy Tân
2	Физика элементов приборных структур	TK	Белорусский государственный университет (Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus), năm 2024	4	VC	(90-118)	Giấy xác nhận sử dụng sách Số 780/GXN-ĐHDT ngày 20/06/2025 của Giám đốc Đại học Duy Tân

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/T K	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Trước khi được công nhận PGS/TS					
1	Tính chất điện tử của ống nano carbon zigzag biến dạng	CN	103.02-2012.14, cấp Bộ	04/04/2013 đến 30/11/2014	17/01/2015; Đạt
Sau khi được công nhận PGS/TS					
2	Ảnh hưởng của biến dạng Peierls lên tính chất truyền dẫn của graphene nanoribbon	CN	103.01-2014.04, cấp Bộ	15/05/2015 đến 08/03/2017	07/07/2017; Đạt
3	Tính chất điện tử và truyền dẫn của một số vật liệu monochalcogenide, dichalcogenide và dị cấu trúc giữa chúng	CN	103.01-2017.309, cấp Bộ	01/08/2018 đến 01/08/2020	25/01/2021; Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi được công nhận PGS/TS								
1	Interwall conductance in double-walled armchair carbon nanotubes	7	Không	Physics Letters A	Có - SCIE IF: 1.705 (năm 2007); Q2	6	372, 35, 5706–5711	08/2008
2	Uniaxially deformed (5,5) carbon nanotube: Structural transitions	7	Không	Chemical Physics Letters	Có - SCIE IF: 2.226 (năm 2007); Q2	7	464, 4-6, 187–191	10/2008

3	Магнитоуправляемое реле на основе двух углеродных нанотрубок, наполненных эндофуллеренами Fe@C20	5	Không	Вестник Фонда фундаментальных исследований			4, 46, 29–37	12/2008
4	Fullerene C20 motion in (8,8) carbon nanotube	8	Không	Physics, Chemistry and Application of Nanostructures: Proceedings of the International Conference Nanomeeting – 2009, Minsk, Belarus, 26–29 May 2009, World Scientific; ISBN-13: 978-981-4280-35-8			116–119	05/2009
5	Calculation of the field emission current from carbon nanotubes using the Bardeen transfer Hamiltonian method	3	Có	Computational Materials Science	Có - SCIE IF: 1.852 (năm 2009); Q2	1	49, 4, S218–S220	10/2010
6	Effect of Peierls transition in armchair carbon nanotube on dynamical behaviour of encapsulated fullerene	10	Không	Nanoscale Research Letters	Có - SCIE IF: 2.557 (năm 2010); Q1	5	6 216 (10 pages)	03/2011
7	Structural phase transition and band gap of uniaxially deformed (6, 0) carbon nanotube	9	Không	Chemical Physics Letters	Có - SCIE IF: 2.337 (năm 2011); Q2	12	545 71–77	08/2012
8	Electronic band structure of carbon nanotubes with quinoid structure	2	Có	Modern Physics Letters B	Có - SCIE IF: 0.474 (năm 2022); Q3		27, 25, 1350179 (10 pages)	10/2013

9	Band structure of deformed armchair nanoribbon with bond alternation	2	Có	Physica E	Có - SCIE <i>IF: 1.856 (năm 2013); Q2</i>	5	60 91–94	06/2014
10	Peierls instability in (5, 5) and (9, 0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap	2	Có	Physica Status Solidi B	Có - SCIE <i>IF: 1.605 (năm 2013); Q1</i>	1	251, 8, 1614–1618	08/2014
11	Tuning electronic properties of armchair graphene nanoribbons by strain engineering	3	Không	Physica Scripta	Có - SCIE <i>IF: 1.296 (năm 2013); Q2</i>	7	90, 1, 015802 (7 pages)	01/2015
12	Modulation of the band structure in bilayer zigzag graphene nanoribbons on hexagonal boron nitride using the force and electric fields	5	Không	Materials Chemistry and Physics	Có - SCIE <i>IF: 2.259 (năm 2014); Q1</i>	4	154 78–83	03/2015
13	Electric field and substrate–induced modulation of spin-polarized transport in graphene nanoribbons on A3B5 semiconductors	4	Không	Journal of Applied Physics	Có - SCIE <i>IF: 2.183 (năm 2014); Q1</i>	11	117, 17, 174309 (8 pages)	05/2015
14	Effect of electric field on the electronic and magnetic properties of graphene nanoribbons/aluminium nitride bilayer system	4	Không	RSC Advances	Có - SCIE <i>IF: 3.840 (năm 2014); Q1</i>	11	5, 61, 49308–49316	05/2015

15	Ảnh hưởng biến dạng lên tính chất điện tử của armchair graphene nanoribbon	1	Có	Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân			1, 18, 26–31	03/2016
Sau khi được công nhận PGS/TS								
16	First-principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces	7	Có	Journal of Applied Physics	Có - SCIE IF: 2.068 (năm 2016); Q1	48	122, 10, 104301 (7 pages)	09/2017
17	Electronic properties of GaSe/MoS2 and GaS/MoSe2 heterojunctions from first principles calculations	5	Không	AIP Advances	Có - SCIE IF: 1.653 (năm 2010); Q2	22	8, 7, 075207 (9 pages)	07/2018
18	First principles study of the electronic properties and Schottky barrier in vertically stacked graphene on the Janus MoSeS under electric field	7	Không	Computational Materials Science	Có - SCIE IF: 2.530 (năm 2017); Q1	61	153 438–444	10/2018
19	Layered graphene/GaS van der Waals heterostructure: Controlling the electronic properties and Schottky barrier by vertical strain	7	Không	Applied Physics Letters	Có - SCIE IF: 3.495 (năm 2017); Q1	161	113, 17, 171605 (5 pages)	10/2018
20	Synergy of physical properties of low-dimensional carbon-based systems for	7	Không	Materials Research Express	Có - SCIE IF: 1.597 (năm 2017); Q1	29	6, 4, 042002 [Review]	01/2019

	nanoscale device design							
21	Modulation of electronic properties of monolayer InSe through strain and external electric field	8	Không	Chemical Physics	Có - SCIE IF: 1.707 (năm 2017); Q2	13	516 213–217	01/2019
22	Strain and electric field tunable electronic properties of type-II band alignment in van der Waals GaSe/MoSe2 heterostructure	6	Không	Chemical Physics	Có - SCIE IF: 1.822 (năm 2018); Q2	20	521 92–99	05/2019
23	Quantum Chemical Calculation of Reactions Involving C20, C60, Graphene and H2O	5	Không	International Journal of Nanoscience	Có - ESCI IF: Q3		18, 3&4, 1940008 (5 pages)	05/2019
24	Interlayer coupling and electric field controllable Schottky barriers and contact types in graphene/PbI2 heterostructures	7	Không	Physical Review B	Có - SCIE IF: 3.575 (năm 2019); Q1	84	101 235419 (8 pages)	05/2020
25	Electronic and optical properties of a Janus SnSSe monolayer: effects of strain and electric field	7	Có	Physical Chemistry Chemical Physics	Có - SCIE IF: 3.430 (năm 2010); Q1	90	22, 20, 11637–11643	05/2020
26	Ảnh hưởng của biến dạng phẳng lên tính chất điện tử và quang học của đơn lớp GaSe	4	Có	Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên			129, 1C, 109–116	06/2020
27	Quantum chemical	7	Không	Semiconductors	Có - SCIE IF: 0.691		54 1678–1681	07/2020

	calculations of carbon nanoscroll energy rolled from zigzag graphene nanoribbon				(năm 2019); Q4			
28	Computational prediction of electronic and optical properties of Janus Ga ₂ SeTe monolayer	4	Có	Journal of Physics D: Applied Physics	Có - SCIE IF: 3.169 (năm 2019); Q1	33	53, 45, 455302 (10 pages)	08/202 0
29	Electronic, optical and mechanical properties of graphene/MoS ₂ nanocomposite	5	Không	Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật – Học viện Kỹ thuật Quân sự			209 5–16	08/202 0
30	Interfacial characteristics, Schottky contact, and optical performance of a graphene/Ga ₂ S Se van der Waals heterostructure: Strain engineering and electric field tunability	10	Không	Physical Review B	Có - SCIE IF: 3.575 (năm 2019); Q1	140	102 075414 (10 pages)	08/202 0
31	The geometry of a bilayer nanoscroll rolled from zigzag nanoribbons of graphene and boron nitride	7	Không	Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics series			56, 4, 411–418	11/202 0
32	Theoretical prediction of electronic, transport, optical, and thermoelectric properties of Janus monolayers	10	Có	Physical Review B	Có - SCIE IF: 3.575 (năm 2019); Q1	99	103 085422 (14 pages)	02/202 1

	In ₂ XO (X = S, Se, Te)							
33	Multi-orbital tight binding model for the electronic and optical properties of armchair graphene nanoribbons in the presence of a periodic potential	4	Có	Journal of Physics: Condensed Matter	Có - SCIE IF: 2.707 (năm 2019); Q1	3	33, 15, 155702 (8 pages)	02/2021
34	Electronic, optical, and thermoelectric properties of Janus In-based monochalcogenides	9	Có	Journal of Physics: Condensed Matter	Có - SCIE IF: 2.333 (năm 2020); Q1	38	33, 22, 225503 (13 pages)	05/2021
35	Hexagonal boron nitride (h-BN) nanosheet as a potential hydrogen adsorption material: A density functional theory (DFT) study	4	Không	Surfaces and Interfaces	Có - SCIE IF: 4.8 (năm 2020); Q1	91	24 101043 (8 pages)	06/2021
36	Theoretical prediction of the structural and electronic properties of a single layer graphene-like two-dimensional Janus GaInSTe	3	Không	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics			37, 2, 93–99	06/2021
37	Controlling electronic and optical properties of zigzag graphene nanoribbons by a modulated electric field: significance of σ bands	5	Có	Journal of the Optical Society of America B	Có - SCIE IF: 4.036 (năm 2020); Q1	1	38, 8, 2284– 2289	08/2021

38	A theoretical study on elastic, electronic, transport, optical and thermoelectric properties of Janus SnSO monolayer	5	Có	Journal of Physics D: Applied Physics	Có - SCIE IF: 3.207 (năm 2020); Q1	12	54, 47, 475306 (11 pages)	09/202 1
39	Oxygenation of Janus group III monochalcogenides: First-principles insights into GaInXO (X = S, Se, Te) monolayers	5	Có	Physical Review B	Có - SCIE IF: 4.036 (năm 2020); Q1	28	104 115410 (10 pages)	09/202 1
40	Structural, electronic, and transport properties of Janus GaInX ₂ (X = S, Se, Te) monolayers: First-principles study	6	Có	Journal of Physics: Condensed Matter	Có - SCIE IF: 2.333 (năm 2020); Q1	9	34, 4, 045501 (9 pages)	01/202 2
41	Structural, electronic, and transport properties of quintuple atomic Janus monolayers Ga ₂ SX ₂ (X = O, S, Se, Te): First-principles predictions	4	Có	Physical Review B	Có - SCIE IF: 4.036 (năm 2020); Q1	69	105 075402 (11 pages)	02/202 2
42	Novel Janus group III chalcogenide monolayers Al ₂ XY ₂ (X/Y = S, Se, Te): first-principles insight onto the structural, electronic, and transport properties	2	Có	Journal of Physics: Condensed Matter	Có - SCIE IF: 2.333 (năm 2020); Q1	8	34, 11, 115601 (9 pages)	03/202 2
43	Rashba-type spin splitting	6	Có	Physical Chemistry Chemical Physics	Có - SCIE IF: 3.945	27	24, 27, 16512–	06/202 2

	and transport properties of novel Janus XWGeN ₂ (X = O, S, Se, Te) monolayers				(năm 2021); Q1		16521	
44	Tunable electronic properties of novel 2D Janus MSiGeN ₄ (M = Ti, Zr, Hf) monolayers by strain and external electric field, 2022, 5, 2200499	4	Có	Advanced Theory and Simulations	Có - SCIE IF: 4.105 (năm 2021); Q1	10	5, 11, 2200499 (8 pages)	08/2022
45	Chemical functionalization of SnAs monolayer: a first-principles study of SnAsX (X = Cl, Br, and I) monolayers	6	Có	Journal of Physics D: Applied Physics	Có - SCIE IF: 3.409 (năm 2021); Q1	9	55, 50, 505302 (11 pages)	11/2022
46	Enhanced out-of-plane piezoelectricity and carrier mobility in Janus γ -Sn ₂ XY (X/Y = S, Se, Te) monolayers: A first-principles prediction	4	Có	Applied Physics Letters	Có - SCIE IF: 3.971 (năm 2021); Q1	40	122, 6, 061601 (7 pages)	02/2023
47	New C ₂ h phase of group III monochalcogenide monolayers AlX (X = S, Se, and Te) with anisotropic crystal structure: first-principles study	6	Có	RSC Advances	Có - SCIE IF: 4.036 (năm 2021); Q1	2	13, 10, 6838– 6846	02/2023
48	First-principles examination of two-dimensional Janus quintuple-layer atomic structures	5	Có	Nanoscale Advances	Có - SCIE IF: 5.598 (năm 2022); Q1	9	5, 11, 3104– 3113	05/2023

	XCrSiN ₂ (X = S, Se, and Te)							
49	Structural, electronic, and transport properties of Janus XMoSiP ₂ (X = S, Se, Te) monolayers: a first-principles study	7	Không	Journal of Physics D: Applied Physics	Có - SCIE IF: 3.409 (năm 2022); Q1	7	56, 38, 385306 (13 pages)	06/2023
50	Strain-induced phase transitions and high carrier mobility in two-dimensional Janus MGeSN ₂ (M = Ti, Zr, and Hf) structures: first-principles calculations	4	Có	Physical Chemistry Chemical Physics	Có - SCIE IF: 3.3 (năm 2022); Q1	1	25, 27, 18075–18085	06/2023
51	Anisotropic crystal structure and high electron mobility of novel ternary Janus P6XY monolayers (X/Y = S, Se, Te): First-principles examinations	4	Có	Advanced Theory and Simulations	Có - SCIE IF: 3.3 (năm 2022); Q1	1	6, 11, 2300471 (9 pages)	08/2023
52	Negative Poisson's ratio and anisotropic carrier mobility in ternary Janus Si ₂ XY (X/Y = S, Se, Te): First-principles prediction	3	Có	Applied Physics Letters	Có - SCIE IF: 4.0 (năm 2022); Q1	19	123, 9, 092102 (7 pages)	08/2023
53	First-principles investigations of metal–semiconductor MoSH@MoS ₂ van der Waals heterostructures	5	Không	Nanoscale Advances	Có - SCIE IF: 4.7 (năm 2022); Q1	6	5, 18, 4979–4985	08/2023

54	Tunable electronic properties, carrier mobility, and contact characteristics in type-II BSe/Sc2CF2 heterostructures toward next-generation optoelectronic devices	5	Không	Langmuir	Có - SCIE IF: 3.9 (năm 2022); Q1	9	39, 48, 17251–1 7260	11/202 3
55	Two-dimensional Janus Si2OX (X = S, Se, Te) monolayers as auxetic semiconductors: theoretical prediction	5	Có	RSC Advances	Có - SCIE IF: 3.9 (năm 2022); Q2	2	14, 7, 4966– 4974	01/202 4
56	Theoretical prediction of electronic properties and contact barriers in a metal/semiconductor NbS2/Janus MoSSe van der Waals heterostructure	5	Không	Nanoscale Advances	Có - SCIE IF: 4.7 (năm 2022); Q1	6	6, 4, 1193– 1201	02/202 4
57	Controllable electronic properties, contact barriers and contact types in a TaSe2/WSe2 metal–semiconductor heterostructure	5	Không	Physical Chemistry Chemical Physics	Có - SCIE IF: 3.3 (năm 2022); Q1	4	26, 12, 9657– 9664	03/202 4
58	Spin–orbit coupling tunable electronic properties of 1T'-MoS2 and ternary Janus 1T'-MoSSe monolayers:	8	Có	Chemical Physics	Có - SCIE IF: 2.3 (năm 2023); Q2	2	583 112300 (7 pages)	07/202 4

	Theoretical prediction							
59	Achieving ultra-low contact barriers in MX ₂ /SiH (M = Nb, Ta; X = S, Se) metal–semiconductor heterostructures : first-principles prediction	5	Không	Nanoscale Advances	Có - SCIE IF: 3.6 (năm 2023); Q1		6, 19, 4900– 4906	07/2024
60	Janus piezoelectric ZrSiZ ₃ H (Z = N, P, As) semiconductors with Raman response and high carrier mobility by a first-principles investigation	7	Có	Surfaces and Interfaces	Có - SCIE IF: 5.7 (năm 2023); Q1	1	52 104975 (9 pages)	09/2024
61	Unveiling versatile electronic properties and contact features of metal–semiconductor graphene/ γ -Ge ₂ SSe van der Waals heterostructures	7	Không	Langmuir	Có - SCIE IF: 3.7 (năm 2023); Q1		40, 39, 20783–2 0790	09/2024
62	Monolayers Sn ₂ Te ₂ X ₄ (X = P, As) as promising materials for photocatalytic water splitting and flexible devices: a DFT study	5	Có	Nanoscale Advances	Có - SCIE IF: 3.6 (năm 2023); Q1	4	6, 23, 6019– 6028	12/2024
63	Raman response, piezoelectricity, and transport properties of the two-dimensional Janus HfSiX ₃ H (X = N/P/As)	6	Không	Physical Review B	Có - SCIE IF: 3.2 (năm 2023); Q1	1	110 235403 (11 pages)	12/2024

	semiconductors: A first-principles study							
64	Goldene: A promising electrode for achieving ultra-low Schottky contact in metal–semiconductor Goldene/MX2 (M = Mo,W; X = S, Se) heterostructure	5	Không	Materials Science in Semiconductor Processing	Có - SCIE IF: 4.2 (năm 2023); Q1	2	185 108986 (7 pages)	01/2025
65	High stability Janus structures of two dimensional Fe3GeTe2 monolayer by first-principles investigations	7	Không	Materials Science in Semiconductor Processing	Có - SCIE IF: 4.2 (năm 2023); Q1		186 109055 (8 pages)	02/2025
66	Raman activity and high electron mobility of piezoelectric semiconductor GaSiX2 (X = N, P, and As) toward flexible nanoelectronic devices	6	Có	Journal of Physics D: Applied Physics	Có - SCIE IF: 3.1 (năm 2023); Q1		58, 10, 105309 (11 pages)	03/2025
67	Electric field-driven the electronic properties and contact behavior of the metal/semiconductor NbS2/Sc2CF2 heterostructure	6	Không	Dalton Transactions	Có - SCIE IF: 3.5 (năm 2023); Q1		54, 17, 7080– 7087	05/2025

68	First principles unveiling the metallic TaS ₂ /GeC heterostructure as an anode material in sodium-ion batteries	5	Không	RSC Advances	Có - SCIE IF: 3.9 (năm 2023); Q1		15, 21, 16484– 16492	05/202 5
69	Tunable Raman activity and enhanced piezoelectricity of AlGeZ ₂ (Z = N, P, and As) monolayers: A first-principles calculation	6	Có	Ceramics International	Có - SCIE IF: 5.1 (năm 2024); Q1		51, 14, 19562– 19567	06/202 5
70	First principles exploring the tunable electronic and optical features of silicane/γ-GeSe heterostructures for advanced electronic devices	5	Có	Nanoscale Advances	Có - SCI IF: 4.6 (năm 2024); Q1		7, 12, 3784– 3791	06/202 5

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 28 ([16] [25] [28] [32] [33] [34] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [50] [51] [52] [55] [58] [60] [62] [66] [69] [70])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: 0 / []

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T T	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò U'V (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
1	Chương trình đào tạo ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán trình độ tiến sĩ	Chủ trì	QĐ thành lập Ban soạn thảo đề án Số 5370 ngày 31/12/2020; QĐ thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo Số 5373/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2020	Trường Đại học Duy Tân	QĐ Ban hành chương trình đào tạo số 1335/QĐ-ĐHDT ngày 22/3/2021; QĐ cho phép Trường ĐH Duy Tân đào tạo ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán trình độ tiến sĩ số 559/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2022 của Bộ GD&ĐT	Phó Ban soạn thảo đề án; Tổ trưởng Tổ soạn thảo soạn thảo chương trình đào tạo
2	Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện trình độ đại học	Tham gia	QĐ thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo Số 5362/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2020	Trường Đại học Duy Tân	QĐ Ban hành chương trình đào tạo Số 1878/QĐ-ĐHDT ngày 26/4/2021; QĐ mở ngành đào tạo Kỹ thuật điện trình độ đại học hệ chính quy số 2605/QĐ-ĐHDT ngày 14/07/2021	Thành viên tổ soạn thảo chương trình đào tạo
3	Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật y sinh trình độ đại học	Tham gia	QĐ thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo Số 5364/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2020	Trường Đại học Duy Tân	QĐ Ban hành chương trình đào tạo Số 1879/QĐ-ĐHDT ngày 26/4/2021; QĐ mở ngành đào tạo Kỹ thuật y sinh trình độ đại học hệ chính quy số 2606/QĐ-ĐHDT ngày 14/07/2021	Thành viên tổ soạn thảo chương trình đào tạo

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (U'V PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)